

File 351:Derwent WPI 1963-2004/UD,UM &UP=200456

(c) 2004 Thomson Derwent

\*File 351: For more current information, include File 331 in your search.  
Enter HELP NEWS 331 for details.

1/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI  
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

016371524 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 2004-529431/200451

XRPX Acc No: N04-419693

Exposure method in semiconductor device manufacture, involves projecting image of pattern on substrate through liquid filled between transparent sheet and projection optical system, and substrate and projection optical system

Patent Assignee: NIKON CORP (NIKR )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 2004193252	A	20040708	JP 2002357956	A	20021210	200451 B

Priority Applications (No Type Date): JP 2002357956 A 20021210

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 2004193252	A	15	H01L-021/027	

Abstract (Basic): JP 2004193252 A

NOVELTY - The method involves exposing the substrate (P) by projecting the image of a pattern through the liquid (50A) filled between the transparent sheet (8) and projection optical system (PL), and the liquid (50B) filled between the substrate and projection optical system.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for device manufacturing method.

USE - For exposure processing for pattern transfer in manufacture of micro device such as semiconductor device and also for liquid crystal display (LCD) device.

ADVANTAGE - Flowing of the liquid to the outer side of the substrate is prevented, while preventing generation of problems in later chemical mechanical polishing process.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a structure of the exposure apparatus.

- transparent sheet (8)
- liquids (50A,50B)
- mask (M)
- substrate (P)
- projection optical system (PL)

pp; 15 DwgNo 2/9

Title Terms: EXPOSE; METHOD; SEMICONDUCTOR; DEVICE; MANUFACTURE; PROJECT; IMAGE; PATTERN; SUBSTRATE; THROUGH; LIQUID; FILLED; TRANSPARENT; SHEET; PROJECT; OPTICAL; SYSTEM; SUBSTRATE; PROJECT; OPTICAL; SYSTEM

Derwent Class: P81; P84; U11; U14

International Patent Class (Main): H01L-021/027

International Patent Class (Additional): G02B-013/24; G03F-007/20

File Segment: EPI; EngPI

(19)日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-193252

(P2004-193252A)

(43)公開日 平成16年7月8日(2004.7.8)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>  
**H01L 21/027**  
**G02B 13/24**  
**G03F 7/20**

F 1  
**HO1 L 21/30**    **515 D**  
**GO2 B 13/24**  
**GO3 F 7/20**    **521**

テーマコード(参考)  
**2H087**  
**5FO46**

(21)出願番号  
(22)出願日

特願2002-357956 (P2002-357956)  
平成14年12月10日 (2002.12.10)

(71)出願人 000004112  
株式会社ニコン  
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  
(74)代理人 100064908  
弁理士 志賀 正武  
(74)代理人 100108578  
弁理士 高橋 詔男  
(74)代理人 100101465  
弁理士 青山 正和  
(74)代理人 100107836  
弁理士 西 和哉  
(72)発明者 日高 康弘  
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株  
式会社ニコン内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】露光方法及びアライス製造方法

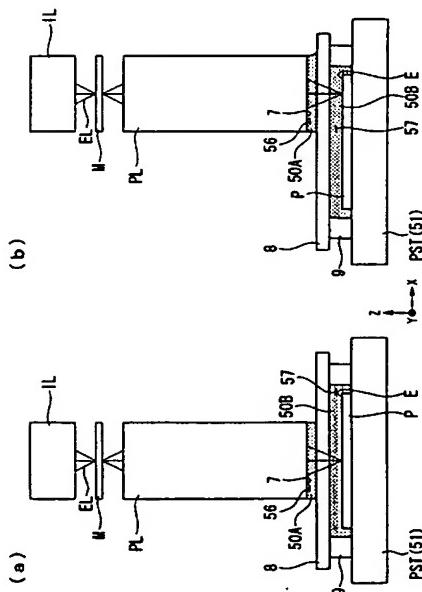
## (57)【要約】

【課題】液浸法で基板のエッジ領域を露光する際、基板の外側への液体の流出を防ぎつつ露光処理できる露光方法を提供する。

【解決手段】投影光学系PLと基板Pとの間の少なくとも一部を液体で満たし、液体と投影光学系PLとを介してパターンの像を基板P上に投影することによって、基板Pを露光する際、基板Pと投影光学系PLとの間に配置された透明板8と、透明板8と投影光学系PLとの間に満たされた液体とを介して基板P上にパターンの像を投影する。

【選択図】

図2



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

投影光学系と基板との間の少なくとも一部を液体で満たし、前記液体と前記投影光学系とを介してパターンの像を前記基板上に投影することによって、前記基板を露光する露光方法において、

前記基板と前記投影光学系との間に配置された透明板と、前記透明板と前記投影光学系との間に満たされた液体とを介して前記基板上にパターンの像を投影することを特徴とする露光方法。

**【請求項 2】**

前記基板と前記透明板との間に液体が満たされていることを特徴とする請求項 1 記載の露光方法。 10

**【請求項 3】**

前記透明板は前記基板より大きいことを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の露光方法。

**【請求項 4】**

投影光学系と基板との間の少なくとも一部を液体で満たし、前記液体と前記投影光学系とを介してパターンの像を前記基板上に投影することによって、前記基板を露光する露光方法において、

前記基板と前記投影光学系との間に配置された、前記基板より大きい透明板と前記液体とを介して前記基板上にパターンの像を投影することを特徴とする露光方法。

**【請求項 5】**

前記液体は、前記透明板と前記基板との間に満たされていることを特徴とする請求項 4 記載の露光方法。 20

**【請求項 6】**

前記透明板は、前記投影光学系の先端の光学素子と兼用することを特徴とする請求項 4 又は 5 記載の露光方法。

**【請求項 7】**

投影光学系と基板との間の少なくとも一部を液体で満たし、前記液体と前記投影光学系とを介してパターンの像を前記基板上に投影することによって、前記基板を露光する露光方法において、

前記基板の周囲の少なくとも一部をカバー部材で覆い、前記基板の外側への前記液体の流出を抑えることを特徴とする露光方法。 30

**【請求項 8】**

前記カバー部材は、前記基板より大きい透明部材であることを特徴とする請求項 7 記載の露光方法。

**【請求項 9】**

前記カバー部材は所定幅の輪帯状に形成されていることを特徴とする請求項 7 記載の露光方法。

**【請求項 10】**

請求項 1 ~ 請求項 9 のいずれか一項記載の露光方法を用いることを特徴とするデバイス製造方法。 40

**【発明の詳細な説明】****【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、投影光学系と基板との間に液体を満たした状態で基板にパターンを露光する露光方法及びデバイス製造方法に関するものである。

**【0002】****【従来の技術】**

半導体デバイスや液晶表示デバイスは、マスク上に形成されたパターンを感光性の基板上に転写する、いわゆるフォトリソグラフィの手法により製造される。このフォトリソグラフィ工程で使用される露光装置は、マスクを支持するマスクステージと基板を支持する基 50

板ステージとを有し、マスクステージ及び基板ステージを逐次移動しながらマスクのパターンを投影光学系を介して基板に転写するものである。近年、デバイスピターンのより一層の高集積化に対応するために投影光学系の更なる高解像度化が望まれている。投影光学系の解像度は、使用する露光波長が短くなるほど、また投影光学系の開口数が大きいほど高くなる。そのため、露光装置で使用される露光波長は年々短波長化しており、投影光学系の開口数も増大している。そして、現在主流の露光波長は、K r F エキシマレーザの248 nmであるが、更に短波長のA r F エキシマレーザの193 nmも実用化されつつある。また、露光を行う際には、解像度と同様に焦点深度(DOF)も重要なとなる。解像度R、及び焦点深度δはそれぞれ以下の式で表される。

$$R = k_1 \cdot \lambda / NA \quad \dots \quad (1)$$

10

$$\delta = \pm k_2 \cdot \lambda / NA^2 \quad \dots \quad (2)$$

ここで、λは露光波長、NAは投影光学系の開口数、 $k_1$ 、 $k_2$ はプロセス係数である。

(1)式、(2)式より、解像度Rを高めるために、露光波長λを短くして、開口数NAを大きくすると、焦点深度δが狭くなることが分かる。

### 【0003】

焦点深度δが狭くなり過ぎると、投影光学系の像面に対して基板表面を合致させることが困難となり、露光動作時のマージンが不足する恐れがある。そこで、実質的に露光波長を短くして、且つ焦点深度を広くする方法として、例えば下記特許文献1に開示されている液浸法が提案されている。この液浸法は、投影光学系の下面と基板表面との間を水や有機溶媒等の液体で満たし、液体中での露光光の波長が、空気中の $1/n$ (nは液体の屈折率で通常1.2~1.6程度)になることをを利用して解像度を向上するとともに、焦点深度を約n倍に拡大するというものである。

20

### 【0004】

#### 【特許文献1】

国際公開第99/49504号パンフレット

### 【0005】

#### 【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記従来技術には以下に述べる問題が存在する。

上記従来技術は、図9(a)に示す模式図のように、投影光学系PLの像面側である下面と基板(ウエハ)Pとの間を局所的に液体50で満たした状態で、照明光学系Iからの露光光ELでマスクMを照明し、マスクMのパターンの像を基板ステージPSTに支持されている基板Pに露光する構成であり、基板Pの中央付近(中央領域)のショット領域を露光する場合には液体50の基板P外側への流出は生じない。しかしながら、図9(b)に示す模式図のように、基板Pの周辺領域(エッジ領域)Eに露光光ELを照射してこの基板Pのエッジ領域Eを露光しようとすると、基板Pと基板ステージPSTとの段差部分Dで表面張力を維持できなくなり液体50は基板Pの外側や周辺装置に流出してしまう。この場合、液体50なしでは、マスクMのパターンの像が基板P上で結像しないという問題が生じるばかりでなく、この流出した液体50を放置しておくと、基板Pがおかれている環境(湿度など)の変動をもたらし、各種光学的検出装置の検出光の光路上の屈折率の変化を引き起こすなど、所望のパターン転写精度を得られなくなるおそれがある。更に、流出した液体により、基板Pを支持する基板ステージ周辺の機械部品などに錆びを生じさせるなどの不都合も生じる。基板Pのエッジ領域Eを露光しないことで液体を流出させないようにすることも考えられるが、エッジ領域Eにも露光処理を施してパターンを形成しておかないと、後工程である例えばCMP(化学的機械的研磨)処理時において、CMP装置の研磨面に対してウエハである基板Pが片当たりして良好に研磨できないという可能性がある。

30

### 【0006】

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、投影光学系と基板との間を液体で満たした状態で露光処理する場合において、例えば基板のエッジ領域を露光する際にも基板の外側への液体の流出を防ぎつつ露光処理できる露光方法、及びこの露光方法を用い

40

50

るデバイス製造方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するため、本発明は実施の形態に示す図1～図8に対応付けした以下の構成を採用している。

本発明の露光方法は、投影光学系(PL)と基板(P)との間の少なくとも一部を液体(50)で満たし、液体(50)と投影光学系(PL)とを介してパターンの像を基板(P)上に投影することによって、基板(P)を露光する露光方法において、基板(P)と投影光学系(PL)との間に配置された透明板(8、14、15)と、透明板(8、14、15)と投影光学系(PL)との間に満たされた液体(50)とを介して基板(P)上にパターンの像を投影することを特徴とする。10

【0008】

本発明によれば、基板と投影光学系との間に透明板を設けることにより、例えば投影光学系と透明板との間に液体を配置する際、透明板の大きさを基板より十分に大きくしておけば、液体が配置される空間において基板のエッジ領域に対応する部分に段差は形成されない。したがって、基板のエッジ領域を露光する際にも段差による基板外側への液体の流出を抑えることができる。

【0009】

本発明の露光方法は、投影光学系(PL)と基板(P)との間の少なくとも一部を液体(50)で満たし、液体(50)と投影光学系(PL)とを介してパターンの像を基板(P)上に投影することによって、基板(P)を露光する露光方法において、基板(P)と投影光学系(PL)との間に配置された、基板(P)より大きい透明板(8、14、15)と液体(50)とを介して基板(P)上にパターンの像を投影することを特徴とする。20

【0010】

本発明によれば、投影光学系と基板との間に基板より大きい透明板を設けたことにより、液体が配置される空間において透明板により基板のエッジ領域に対応する部分に段差は形成されない。したがって、基板のエッジ領域を露光する際にも段差による基板外側への液体の流出を抑えることができる。

【0011】

本発明の露光方法は、投影光学系(PL)と基板(P)との間の少なくとも一部を液体(50)で満たし、液体(50)と投影光学系(PL)とを介してパターンの像を基板(P)上に投影することによって、基板(P)を露光する露光方法において、基板(P)の周囲の少なくとも一部をカバー部材(15)で覆い、基板(P)の外側への液体(50)の流出を抑えることを特徴とする。30

【0012】

本発明によれば、基板の周囲をカバー部材で覆うことにより、基板外側への液体の流出を防止することができる。したがって、周辺装置に錆びを生じさせるなどの不都合の発生を抑えることができる。

【0013】

本発明のデバイス製造方法は、上記いずれか記載の露光方法を用いることを特徴とする。本発明によれば、基板のエッジ領域を露光処理する際にも基板外側への液体の流出を抑えた状態で液浸法により露光処理できるので、基板の中央領域とエッジ領域との双方に対して良好にパターンを転写することができる。したがって、後工程の例えばCMP処理における基板とCMP装置の研磨面との片当たりといった不都合の発生を防ぐことができるので、所望の性能を有するデバイスを製造することができる。40

【0014】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の露光方法及びデバイス製造方法について図面を参照しながら説明する。図1は本発明の露光方法が適用される露光装置の一実施形態を示す概略構成図である。図1において、露光装置EXは、マスクMを支持するマスクステージMSTと、基板Pを支持

する基板ステージPSTと、マスクステージMSTに支持されているマスクMを露光光ELで照明する照明光学系ILと、露光光ELで照明されたマスクMのパターンの像を基板ステージPSTに支持されている基板Pに投影露光する投影光学系PLと、露光装置EX全体の動作を統括制御する制御装置CONTとを備えている。基板Pと投影光学系PLとの間には透明板8が配置されている。透明板8は支持部材9を介して基板ステージPST上に設けられている。

## 【0015】

ここで、本実施形態では、露光装置EXとしてマスクMと基板Pとを走査方向における互いに異なる向き（逆方向）に同期移動しつつマスクMに形成されたパターンを基板Pに露光する走査型露光装置（所謂スキャニングステッパ）を使用する場合を例にして説明する。以下の説明において、投影光学系PLの光軸AXと一致する方向をZ軸方向、Z軸方向に垂直な平面内でマスクMと基板Pとの同期移動方向（走査方向）をX軸方向、Z軸方向及びY軸方向に垂直な方向（非走査方向）をY軸方向とする。また、X軸、Y軸、及びZ軸まわり方向をそれぞれ、 $\theta_X$ 、 $\theta_Y$ 、及び $\theta_Z$ 方向とする。なお、ここでいう「基板」は半導体ウエハ上にレジストを塗布したものを含み、「マスク」は基板上に縮小投影されるデバイスパターンを形成されたレチクルを含む。

10

## 【0016】

照明光学系ILは、マスクステージMSTに支持されているマスクMを露光光ELで照明するものであり、露光用光源、露光用光源から射出された光束の照度を均一化するオプティカルインテグレータ、オプティカルインテグレータからの露光光ELを集光するコンデンサレンズ、リレーレンズ系、露光光ELによるマスクM上の照明領域をスリット状に設定する可変視野絞り等を有している。マスクM上の所定の照明領域は照明光学系ILにより均一な照度分布の露光光ELで照明される。照明光学系ILから射出される露光光ELとしては、例えば水銀ランプから射出される紫外域の輝線（g線、h線、i線）及びKrFエキシマレーザ光（波長248nm）等の遠紫外光（DUV光）や、ArFエキシマレーザ光（波長193nm）及びF<sub>2</sub>レーザ光（波長157nm）等の真空紫外光（VUV光）などが用いられる。本実施形態では、ArFエキシマレーザ光を用いる。

20

## 【0017】

マスクステージMSTは、マスクMを支持するものであって、投影光学系PLの光軸AXに垂直な平面内、すなわちXY平面内で2次元移動可能及び $\theta_Z$ 方向に微小回転可能である。マスクステージMSTはリニアモータ等のマスクステージ駆動装置MSTDにより駆動される。マスクステージ駆動装置MSTDは制御装置CONTにより制御される。マスクステージMST上のマスクMの2次元方向の位置、及び回転角はレーザ干渉計によりリアルタイムで計測され、計測結果は制御装置CONTに出力される。制御装置CONTはレーザ干渉計の計測結果に基づいてマスクステージ駆動装置MSTDを駆動することでマスクステージMSTに支持されているマスクMの位置決めを行う。

30

## 【0018】

投影光学系PLは、マスクMのパターンを所定の投影倍率 $\beta$ で基板Pに投影露光するものであって、複数の光学素子（レンズ）で構成されており、これら光学素子は金属部材としての鏡筒PKで支持されている。本実施形態において、投影光学系PLは、投影倍率 $\beta$ が例えば1/4あるいは1/5の縮小系である。なお、投影光学系PLは等倍系及び拡大系のいずれでもよい。また、投影光学系PLは光学特性（結像特性）の補正を行う結像特性調整装置PLCを有している。この結像特性調整装置PLCは、例えば投影光学系PLを構成する一部のレンズ群の間隔調整機構や一部のレンズ群のレンズ室内の気体圧力調整機構を有しており、これら調整を行うことにより、投影光学系PLの投影倍率、歪曲収差等の光学特性の補正を行う。結像特性調整装置PLCは制御装置CONTにより制御される。

40

## 【0019】

基板ステージPSTは、基板Pを支持するものであって、基板Pを基板ホルダを介して保持するZステージ51と、Zステージ51を支持するXYステージ52と、XYステージ

50

52を支持するベース53とを備えている。基板ステージPSTはリニアモータ等の基板ステージ駆動装置PSTDにより駆動される。基板ステージ駆動装置PSTDは制御装置CONTにより制御される。Zステージ51を駆動することにより、Zステージ51に保持されている基板PのZ軸方向における位置(フォーカス位置)、及びθX、θY方向における位置が制御される。また、XYステージ52を駆動することにより、基板PのXY方向における位置(投影光学系PLの像面と実質的に平行な方向の位置)が制御される。すなわち、Zステージ51は、基板Pのフォーカス位置及び傾斜角を制御して基板Pの表面をオートフォーカス方式、及びオートレベリング方式で投影光学系PLの像面に合わせ込み、XYステージ52は基板PのX軸方向及びY軸方向における位置決めを行う。なお、ZステージとXYステージとを一体的に設けてよいことは言うまでもない。

10

## 【0020】

基板ステージPST(Zステージ51)上には移動鏡54が設けられている。また、移動鏡54に対向する位置にはレーザ干渉計55が設けられている。基板ステージPST上の基板Pの2次元方向の位置、及び回転角はレーザ干渉計55によりリアルタイムで計測され、計測結果は制御装置CONTに出力される。制御装置CONTはレーザ干渉計55の計測結果に基づいて基板ステージ駆動装置PSTDを駆動することで基板ステージPSTに支持されている基板Pの位置決めを行う。

## 【0021】

基板ステージPSTに支持されている基板Pと投影光学系PLの下面7との間には透明板8が設けられている。透明板8は支持部材9を介して基板ステージPSTのZステージ51に支持されている。透明板8は露光光ELを透過可能な材料により構成されており、本実施形態ではガラスプレートにより構成されている。なお、透明板8は露光光ELに対して透過性を有していればよく、透明板8としてガラスプレート以外のものを採用可能である。透明板8は平行平面板であって上下両面は平坦面である。そして、透明板8は平面視略円形状に設けられ、同じく略円形状に形成されている基板(ウエハ)Pより大きく形成されている。すなわち、透明板8の径は基板Pより大きく(基板Pの径以上に)設定されている。透明板8を支持する支持部材9は略円環状に形成されており、基板Pの周囲に配置されている。

20

## 【0022】

透明板8の上面と投影光学系PLの下面7とは離間しており、投影光学系PLと透明板8との間に空間56が形成されている。また、支持部材9に支持されている透明板8と基板Pとも離間しており、透明板8、支持部材9及びZステージ51の上面との間に空間57が形成されている。空間57は略密閉空間である。

30

## 【0023】

本実施形態では、露光波長を実質的に短くして解像度を向上するとともに、焦点深度を実質的に広くするために、液浸法を適用する。そのため、少なくともマスクMのパターンの像を基板P上に転写している間は、基板Pの表面と投影光学系PLの基板P側の光学素子の先端面(下面)7との間に所定の液体50(50A、50B)が満たされる。本実施形態において、液体50には純水が用いられる。純水は、ArFエキシマレーザ光のみならず、露光光ELを例えば水銀ランプから射出される紫外域の輝線(g線、h線、i線)及びKrFエキシマレーザ光(波長248nm)等の遠紫外光(DUV光)とした場合、この露光光ELを透過可能である。また、投影光学系PLの先端面7には露光光ELを透過可能な平行平面板が設けられている。この平行平面板は投影光学系PLの一部を構成する。

40

## 【0024】

露光装置EXは、投影光学系PLの先端面7と透明板8との間の空間56に所定の液体50Aを供給する液体供給装置1と、空間56の液体50Aを回収する液体回収装置2とを備えている。液体供給装置1は、液体50Aを収容するタンク、加圧ポンプ、及び空間56に対して供給する液体50Aを所定の温度に調整する温度調整装置などを備えている。

液体供給装置1には供給管3の一端部が接続され、供給管3の他端部には供給ノズル4が

50

接続されている。液体供給装置1は供給管3及び供給ノズル4を介して空間56に液体50Aを供給する。ここで、液体供給装置1に設けられている温度調整装置は、空間56に供給する液体50Aの温度を、例えば露光装置EXが収容されているチャンバ内の温度と同程度に設定する。

#### 【0025】

液体回収装置2は、吸引ポンプ、回収した液体50Aを収容するタンクなどを備えている。液体回収装置2には回収管6の一端部が接続され、回収管6の他端部には回収ノズル5が接続されている。液体回収装置2は回収ノズル5及び回収管6を介して空間56の液体50Aを回収する。空間56に液体50Aを満たす際、制御装置CONTは液体供給装置1を駆動し、供給管3及び供給ノズル4を介して空間56に対して単位時間当たり所定量の液体50Aを供給するとともに、液体回収装置2を駆動し、回収ノズル5及び回収管6を介して単位時間当たり所定量の液体50Aを空間56より回収する。これにより、投影光学系PLの先端面7と基板Pとの間の空間56に所定量の液体50Aが配置される。

10

#### 【0026】

また、基板Pと透明板8との間、すなわち空間57にも液体50Bが満たされている。空間57に液体50Bを満たす際には、例えば、露光処理前において基板ステージPST(Zステージ51)上の円環状支持部材9の円環内部に液体50Bを投入し、次いで、支持部材9の上端を透明板8で覆うことにより空間57に液体50Bが満たされる。ここで、空間57は略密閉空間であり、空間57に満たされた液体50Bは空間外部に流出しない。

20

#### 【0027】

次に、上述した露光装置EXを用いてマスクMのパターンを基板Pに露光する方法について図2を参照しながら説明する。

基板ステージPSTに対して基板Pがロードされると、制御装置CONTは、円環状部材である支持部材9の円環内部に液体50Bを投入した後、支持部材9の上端を透明板8で覆う。これにより、基板Pと透明板8との間の空間57に液体50Bが満たされた状態となる。次いで、制御装置CONTは、液体供給装置1及び液体回収装置2それぞれを駆動し、投影光学系PLと透明板8との間に液体50Aの液浸部分を形成する。そして、制御装置CONTは、照明光学系ILによりマスクMを露光光ELで照明し、マスクMのパターンの像を投影光学系PL、透明板8、及び液体50A、50Bを介して基板Pに投影する。ここで、図2(a)の模式図に示すように、基板Pの中央付近(中央領域)のショット領域を露光している間は、液体供給装置1から供給された液体50は液体回収装置2により回収されることで、基板Pの外側に流出しない。

30

#### 【0028】

一方、図2(b)に示すように、基板Pのエッジ領域(基板Pの周縁近傍領域)Eを露光処理する際にも、基板Pと投影光学系PLとの間には基板Pより十分に大きい透明板8が配置されているので、基板Pのエッジの外側にも透明板8の平坦部分が十分に確保される。すなわち、基板Pの中央付近とエッジ付近とのいずれを露光する場合にも、液体50が供給される空間56を、投影光学系PLと透明板8との間に維持することができる。したがって、基板Pのエッジ領域Eを露光する際にも、液体50Aは投影光学系PLと透明板8との間から外部に流出することがなく、基板Pの中央領域に対する露光条件と同等の条件でエッジ領域Eを露光することができる。

40

#### 【0029】

また、空間57は略密閉空間であり、露光処理中において空間57内部の液体50Bは大きく流動しない。したがって、液体の流動による基板P表面に対する影響を抑えることができる。

#### 【0030】

なお、本実施形態の露光装置EXは所謂スキャニングステッパーである。-X方向に基板Pを移動させて走査露光を行う場合、制御装置CONTは-X方向に液体50Aを流す。一方、+X方向に基板Pを移動させて走査露光を行う場合、制御装置CONTは+X方向に

50

液体 50 を流す。このように、制御装置 C O N T は、液体供給装置 1 及び液体回収装置 2 を用いて、基板 P の移動方向に沿って液体 50 を流す。この場合、例えば液体供給装置 1 から供給ノズル 4 を介して供給される液体 50 は基板 P の -X 方向への移動に伴って空間 56 に引き込まれるようにして流れるので、液体供給装置 1 の供給エネルギーが小さくでも液体 50 を空間 56 に容易に供給できる。そして、走査方向に応じて液体 50 を流す方向を切り替えることにより、+X 方向、又は -X 方向のどちらの方向に基板 P を走査する場合にも、レンズ 60 の先端面 7 と基板 P との間を液体 50 で満たすことができ、高い解像度及び広い焦点深度を得ることができる。

## 【0031】

露光処理を行うに際し、例えば空間 57 の液体 50B は流動（交換）していないため温度変化することが考えられ、この場合、温度変化により液体 50A の屈折率が変動する。すると、マスク M のパターンを投影光学系 PL 及び液体 50 を介して基板 P に転写する際、基板 P に転写されるパターンの像に誤差が生じる場合がある。例えば、液体 50 の屈折率変化に伴い、屈折率変化前に比べて基板 P に転写されるパターン像のスケーリングが変動したり、あるいは結像面位置が変動する場合が考えられる。制御装置 C O N T は、求め求めめた液体 50B の温度変化量（屈折率変化量）と基板 P 上でのパターンの結像特性に基づいて、基板 P に転写されるパターンの像に誤差が生じないように、結像特性調整装置 PLC を用いてパターン像の像調整を行う。例えば、液体 50 の屈折率変化に伴って、投影光学系 PL の像面位置が Z 軸方向にシフトした場合には、結像特性調整装置 PLC は、投影光学系 PL 内に設けられている光学素子の一部を駆動することで、投影光学系 PL 及び液体 50 を介したパターンの結像面位置と基板 P の表面とを合致させることができる。あるいは、像調整として、マスク M を Z 軸方向あるいは傾斜方向へ移動したり、あるいは露光光 EL の波長を調整することによっても液体 50 の屈折率変化によってパターンの像に誤差が生じないように像調整を行うことができる。

10

20

30

## 【0032】

以上説明したように、投影光学系 PL と基板 P との間に基板 P より大きい透明板 8 を設けたので、基板 P のエッジ領域 E を露光する際にも液体 50A の外部への流出を抑えることができ、液浸露光を行う際、基板 P の中央領域とエッジ領域とのそれぞれに対して液体配置に関して同一条件で露光することができる。

## 【0033】

上述したように、本実施形態における液体 50 は純水により構成されている。純水は、半導体製造工場等で容易に大量に入手できるとともに、基板 P 上のフォトレジストや光学素子（レンズ）等に対する悪影響がない利点がある。また、純水は環境に対する悪影響がないとともに、不純物の含有量が極めて低いため、基板 P の表面、及び投影光学系 PL の先端面に設けられている光学素子の表面を洗浄する作用も期待できる。

40

## 【0034】

そして、波長が 193 nm 程度の露光光 EL に対する純水（水）の屈折率  $n$  はほぼ 1.47 であるため、露光光 EL の光源として ArF エキシマレーザ光（波長 193 nm）を用いた場合、基板 P 上では  $1/n$ 、すなわち約 1.31 nm に短波長化されて高い解像度が得られる。更に、焦点深度は空気中に比べて約  $n$  倍、すなわち約 1.47 倍に拡大されるため、空気中で使用する場合と同程度の焦点深度が確保できればよい場合には、投影光学系 PL の開口数をより増加させることができ、この点でも解像度が向上する。

## 【0035】

本実施形態では、投影光学系 PL の先端面 7 には露光光 EL を透過可能な平行平面板が設けられている。この平行平面板は投影光学系 PL の先端面に着脱（交換）自在に取り付けられている。液体 50 と接触する光学素子を、レンズより安価な平行平面板とすることにより、露光装置 EX の運搬、組立、調整時等において投影光学系 PL の透過率、基板 P 上での露光光 EL の照度、及び照度分布の均一性を低下させる物質（例えばシリコン系有機物等）がその平行平面板に付着しても、液体 50 を供給する直前にその平行平面板を交換するだけでよく、液体 50 と接触する光学素子をレンズとする場合に比べてその交換コスト

50

トが低くなるという利点がある。すなわち、露光光 E L の照射によりレジストから発生する飛散粒子、または液体 50 中の不純物の付着などに起因して液体 50 に接触する光学素子の表面が汚れるため、その光学素子を定期的に交換する必要があるが、この光学素子を安価な平行平面板とすることにより、レンズに比べて交換部品のコストが低く、且つ交換に要する時間を短くすることができ、メンテナンスコスト（ランニングコスト）の上昇やスループットの低下を抑えることができる。もちろん、投影光学系 P L の先端面に取り付ける光学素子がレンズであってもよい。また、投影光学系 P L の先端面に取り付ける光学素子としては、投影光学系 P L の光学特性、例えば収差（球面収差、コマ収差等）の調整に用いる光学プレートであってもよい。また、投影光学系 P L の先端部において、光学素子（平行平面板やレンズ）のみを液体 50 に接触させ、鏡筒 P K を接触させない構成とすることにより、金属からなる鏡筒 P K の腐蝕等が防止される。

10

## 【0036】

なお、液体 50 A の流れによって生じる投影光学系 P L の先端の光学素子と基板 P との間に大きな圧力が生じる場合には、その光学素子を交換可能とするのではなく、その圧力によって光学素子が動かないように堅固に固定してもよい。

20

## 【0037】

なお、本実施形態の液体 50 は水であるが、水以外の液体であってもよい、例えば、露光光 E L の光源が F<sub>2</sub> レーザである場合、この F<sub>2</sub> レーザ光は水を透過しないので、この場合、液体 50 としては F<sub>2</sub> レーザ光を透過可能な例えばフッ素系オイルであってもよい。また、液体 50 としては、その他にも、露光光 E L に対する透過性があつてできるだけ屈折率が高く、投影光学系 P L や基板 P 表面に塗布されているフォトレジストに対して安定なもの（例えばセダー油）を用いることも可能である。

30

## 【0038】

また、上記実施形態において、空間 56 と空間 57 とのそれには同じ種類の液体が満たされるように説明したが、投影光学系 P L と透明板 8 との間を第 1 の液体で満たし、基板 P と透明板 8 との間を前記第 1 の液体とは別の第 2 の液体で満たすこともできる。

## 【0039】

なお、上記実施形態では、空間 57 は略密閉空間であり、空間 57 の液体 50 B はほぼ流動しないように説明したが、図 3 に示すように、支持部材 9 の一部で第 2 液体供給装置の一部を構成する供給ノズル 10 を支持し、支持部材 9 の他の一部で第 2 液体回収装置の一部を構成する回収ノズル 11 を支持し、これら供給ノズル 10 及び回収ノズル 11 のそれぞれを空間 57 に接続し、露光処理中において、空間 57 に対する液体 50 B の供給及び回収動作を行うようにしてもよい。これにより、空間 57 の液体 50 B は常時交換され、温度調整された液体 50 B が供給されるので、空間 57 における液体 50 B の温度変化を抑制できる。

30

## 【0040】

なお、上記実施形態では、基板ステージ P S T 上に基板 P を配置した後、基板 P の周囲の支持部材 9 の内部に液体 50 B を投入してから透明板 8 で覆うことにより液体 50 B を満たした空間 57 を形成するように説明したが、図 4 に示すように、内部空間 12 A を有する容器 12 を用意し、この容器 12 の内部空間 12 A に液体 50 B 及び基板 P を予め配置しておき、露光処理する際に搬送装置 H により基板 P を容器 12 ごと基板ステージ P S T にロードするようにしてもよい。なお、容器 12 はガラスなどの透明部材により形成され、内部空間 12 A は略密閉空間である。露光処理する際には投影光学系 P L と容器 12 の上面 12 B との間に液体 50 A が液体供給装置 1 より供給される。

40

## 【0041】

また、上記実施形態では、透明板 8 を支持部材 9 で支持しているが、支持部材 9 なしに、液体 50 B を介して透明板 8 と基板 P とを密着させるようにしてもよい。すなわち、基板ステージ P S T 上に基板 P を配置した後、1 ~ 2 mm の厚さで基板 P の全面を覆える程度の液体 50 B を基板 P 上に供給する。そして、そこに透明板 8 を載せて、表面張力により透明板 8 と基板 P との間に液体 50 B を保持する。この場合、基板ステージ P S T の移動

50

により透明板8が動く恐れがある場合には、透明板8を載せた後に、その透明板8を固定してやればよい。

#### 【0042】

次に、図5を参照しながら本発明の第2実施形態について説明する。以下の説明において上述した実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付しその説明を簡略もしくは省略する。

本実施形態の特徴的な部分は、投影光学系PLと基板Pとの間に配置される透明板として、投影光学系PLの先端面に設けられた大きな光学素子である平行平面板14が用いられている点である。本実施形態において、平行平面板(透明板)14の大きさは基板Pより大きく設定されている。また、上述したように、平行平面板14は投影光学系PL(鏡筒PK)に対して着脱可能である。そして、平行平面板14は投影光学系PLの下面に密着あるいは僅かに離間しており、水平方向に移動可能(スライド可能)に設けられている。平行平面板14の一部は支持部材13を介して基板ステージPST(Zステージ51)の上面に接続されている。ここで、支持部材13は平行平面板14の複数の所定位置と基板ステージPSTとを接続する棒部材により構成されている。図5(a)に示すように、基板Pを露光する際には、制御装置CONTは、第1供給装置1に接続している供給ノズル4より平行平面板14と基板Pとの間に液体50を供給するとともに第2回収装置2に接続している回収ノズル5より液体50を回収しつつ、平行平面板14及び液体50を介してマスクMのパターンの像を基板Pに露光する。そして、図5(b)に示すように基板Pのエッジ領域Eに対してパターンの像を露光する際にも、基板Pより大きい平行平面板14が基板Pと投影光学系PLとの間に配置されているので、基板Pと平行平面板14との間に液体50を満たした状態でエッジ領域Eを露光することができる。

#### 【0043】

次に、図6を参照しながら本発明の第3実施形態について説明する。本実施形態の特徴的部分は、基板Pの周囲に基板P外側への液体50の流出を抑えるカバー部材15を設けた点である。

図6において、基板Pの周囲には支持部材9が設けられており、支持部材9の上端にはカバー部材15が接続されている。カバー部材15は、図7に示す平面図のように所定幅15Dを有する輪帯状に形成されている。このカバー部材15の幅15Dは例えば投影光学系PLの下面7の半径以上に設定されている。カバー部材15は例えばガラス等の透明部材により形成されている。そして、図6(a)に示すように、カバー部材15の上面は基板Pの上面より高く設定されるとともに、カバー部材15と基板Pとは離間している。また、カバー部材15の内側領域15Aと基板Pのエッジ領域Eとは水平方向において重複するように設定されている。すなわち、カバー部材15の内径は基板Pの外径より小さく設定されている。一方、カバー部材15の外径は基板Pより十分大きく設定されている。

#### 【0044】

基板Pの中央付近のショット領域を露光する際には、図6(a)に示すように投影光学系PLと基板Pとの間に液体50が満たされる。一方、基板Pのエッジ領域Eを露光する際には、図6(b)に示すように液体50はカバー部材15及びこれを支持する支持部材9により外側への流出が抑えられる。特に、カバー部材15の外径が基板Pより大きく設定されており、カバー部材15の上面は基板Pの上面より高く設定されているので、エッジ領域Eを露光する際の液体50の流出を確実に抑えることができる。

#### 【0045】

なお、本実施形態の基板Pとしては、半導体デバイス製造用の半導体ウエハのみならず、ディスプレイデバイス用のガラス基板や、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウエハ、あるいは露光装置で用いられるマスクまたはレチカルの原版(合成石英、シリコンウエハ)等が適用される。

#### 【0046】

露光装置EXとしては、マスクMと基板Pとを同期移動してマスクMのパターンを走査露

10

20

30

40

50

光するステップ・アンド・スキャン方式の走査型露光装置（スキヤニングステッパー）の他に、マスクMと基板Pとを静止した状態でマスクMのパターンを一括露光し、基板Pを順次ステップ移動させるステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置（ステッパー）にも適用することができる。また、本発明は基板P上で少なくとも2つのパターンを部分的に重ねて転写するステップ・アンド・ステイッチ方式の露光装置にも適用できる。

## 【0047】

露光装置EXの種類としては、基板Pに半導体素子パターンを露光する半導体素子製造用の露光装置に限らず、液晶表示素子製造用又はディスプレイ製造用の露光装置や、薄膜磁気ヘッド、撮像素子（CCD）あるいはレチクル又はマスクなどを製造するための露光装置などにも広く適用できる。

10

## 【0048】

また、本発明は、特開平10-163099号公報、特開平10-214783号公報、特表2000-505958号公報などに開示されているツインステージ型の露光装置にも適用できる。

## 【0049】

基板ステージPSTやマスクステージMSTにリニアモータ（U.S.P. 5, 623, 853またはU.S.P. 5, 528, 118参照）を用いる場合は、エアベアリングを用いたエア浮上型およびローレンツ力またはリアクタンス力を用いた磁気浮上型のどちらを用いてもよい。また、各ステージPST、MSTは、ガイドに沿って移動するタイプでもよく、ガイドを設けないガイドレスタイプであってもよい。

20

## 【0050】

各ステージPST、MSTの駆動機構としては、二次元に磁石を配置した磁石ユニットと、二次元にコイルを配置した電機子ユニットとを対向させ電磁力により各ステージPST、MSTを駆動する平面モータを用いてもよい。この場合、磁石ユニットと電機子ユニットとのいずれか一方をステージPST、MSTに接続し、磁石ユニットと電機子ユニットとの他方をステージPST、MSTの移動面側に設ければよい。

## 【0051】

基板ステージPSTの移動により発生する反力は、投影光学系PLに伝わらないように、特開平8-166475号公報（U.S.P. 5, 528, 118）に記載されているように、フレーム部材を用いて機械的に床（大地）に逃がしてもよい。

30

マスクステージMSTの移動により発生する反力は、投影光学系PLに伝わらないように、特開平8-330224号公報（U.S.P. 5, 528, 118）に記載されているように、フレーム部材を用いて機械的に床（大地）に逃がしてもよい。

## 【0052】

以上のように、本願実施形態の露光装置EXは、本願特許請求の範囲に挙げられた各構成要素を含む各種サブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精度を保つよう組み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、この組み立ての前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整、各種機械系については機械的精度を達成するための調整、各種電気系については電気的精度を達成するための調整が行われる。各種サブシステムから露光装置への組み立て工程は、各種サブシステム相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種サブシステムから露光装置への組み立て工程の前に、各サブシステム個々の組み立て工程があることはいうまでもない。各種サブシステムの露光装置への組み立て工程が終了したら、総合調整が行われ、露光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の製造は温度およびクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。

40

## 【0053】

半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図8に示すように、マイクロデバイスの機能・性能設計を行うステップ201、この設計ステップに基づいたマスク（レチクル）を製作するステップ202、デバイスの基材である基板を製造するステップ203、前述した実施形態の露光装置EXによりマスクのパターンを基板に露光する露光処理ステップ204

50

、デバイス組み立てステップ（ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージ工程を含む）205、検査ステップ206等を経て製造される。

[0054]

#### 【発明の効果】

本発明によれば、液浸法により基板を露光する場合において、基板のエッジ領域を露光する際にも基板外側への液体の流出を抑えることができる。したがって、流出した液体による周辺装置の錆びの発生や露光処理環境の変化といった不都合の発生を抑えることができる。また、基板の中央領域とエッジ領域との双方に対して良好にパターンを転写することができるので、後工程のC M P処理において基板とC M P装置の研磨面との片当たりといった不都合の発生を防ぐことができる。したがって、所望の性能を有するデバイスを製造することができる。

10

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の露光方法に用いる露光装置の一実施形態を示す概略構成図である。

【図2】 李登明の鑑光左法の第1書簡形態を説明するための模式図である。

【図3】 李登明の鑑賞方法の範囲を説明するための模式図である。

【図4】 杰登明の露光方法の変形例と説明するための模式図である。

【図5】本発明の露光方法の変形態を説明するための模式図である。図5は、模擬試験用に作成された試験用試料板の露光部を示す。

【図6】本登明の露光方法第3式と実態を説明するための模式圖である。

【図3】カバー部材を示す平面図である。

図8-2 半導体ダイ正面の構造図である。

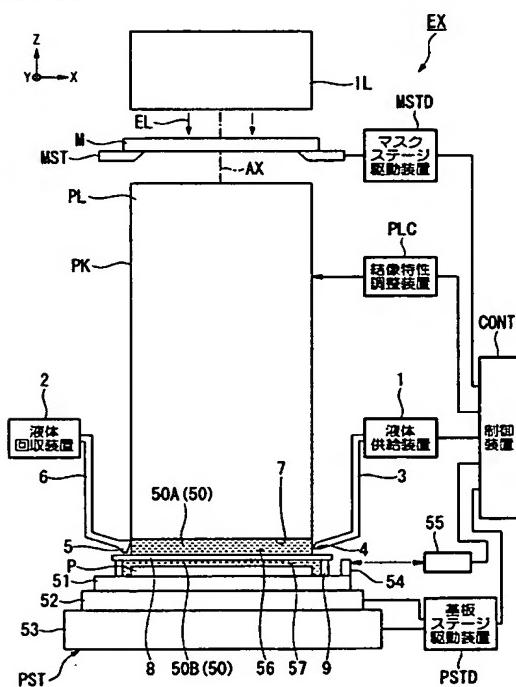
【図9】従来の課題を説明するための模式図である

### 【図9】従来の 【算用の説明】

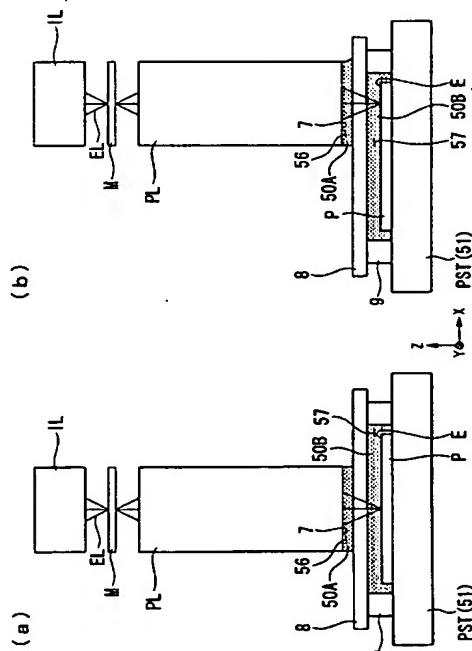
〔符号の説明〕  
 8…透明板、14…平行平面板（透明板、光学素子）、15…カバー部材、  
 50（50A、50B）…液体、EX…露光装置、M…マスク、P…基板、  
 P-L…投影光学系

20

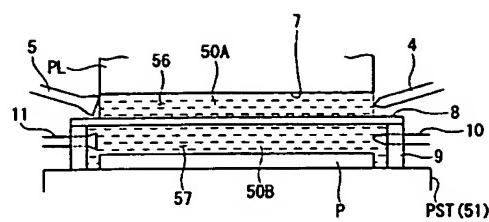
[圖 11]



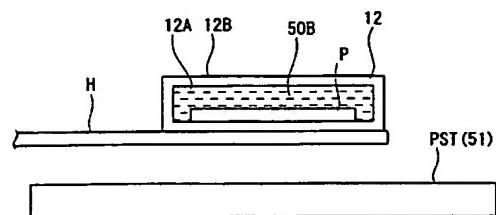
[图2]



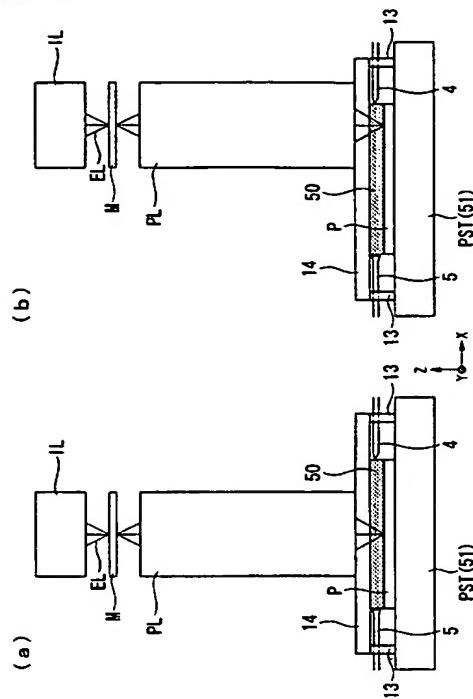
【図3】



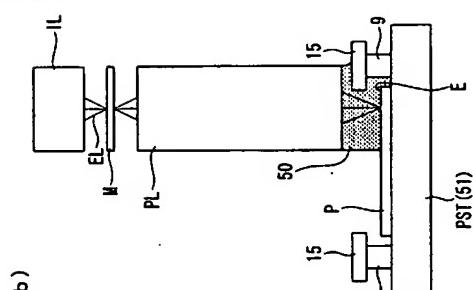
【図4】



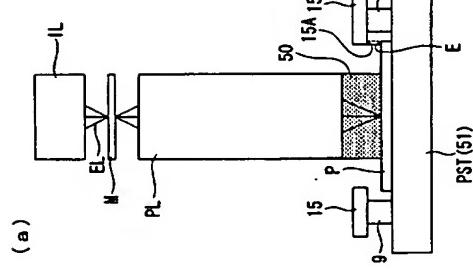
【図5】



【図6】

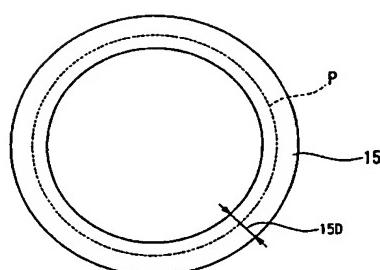


(b)

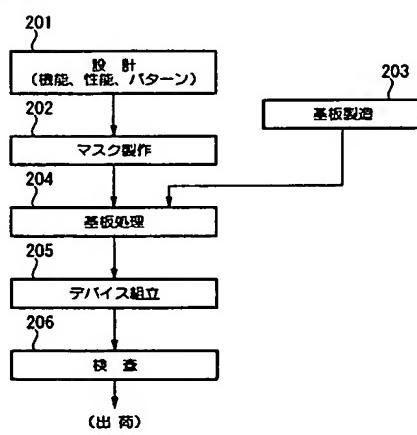


(a)

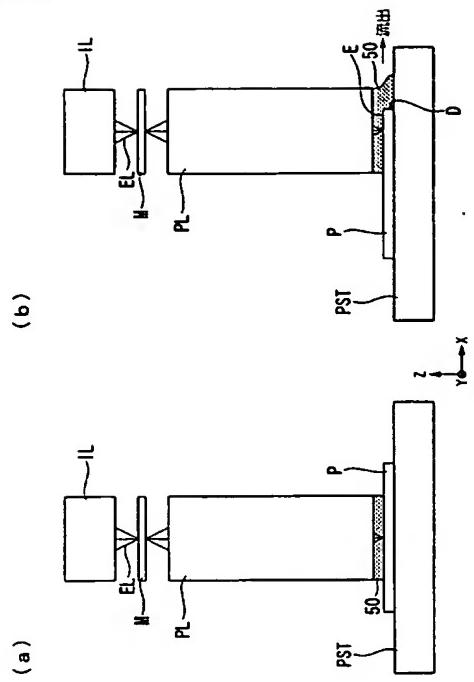
【図7】



【図8】



【図9】



---

フロントページの続き

(72)発明者 大和 壮一  
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

(72)発明者 内川 清  
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

F ターム(参考) 2H087 KA21 LA21 NA04 UA09  
5F046 BA04 BA05 CB12 CB19 CB27